

表3

序号	设备名称	数量 (台/套)	主要技术参数
1	高性能等离子加工设备	1	1. 等离子射流速度：≥2马赫 2. 最大功率120kW，工作效率90%以上； 3. 支持材料：金属、陶瓷、碳化物及复合粉末； 4. 气体管理：进口质量流量控制器（闭环控制），实时监测主气/次气压力与流量； 5. 工作台直径不小于500mm； 6. 配备手持及机装喷枪各一把，采用枪外送粉，双筒无级送粉器；
2	高真空多腔室PVD/CVD复合薄膜镀膜机	1	一、PECVD室 极限真空度：5.0×10 ⁻⁵ Pa；样品台：室温-600oC、可旋转、可升降；配备辅助磁控溅射阴极，以及阴极配套射频溅射和偏压电源；配备废气处理系统。 二、电子束与电阻式热蒸发室 极限真空度：5.0×10 ⁻⁵ Pa；样品台：室温-600oC、可旋转、可升降；配备电子枪蒸发源和电阻式蒸发源，以及配套电源；配备膜厚监测系统。 三、空心阴极室 极限真空度：5.0×10 ⁻⁵ Pa；样品台：室温-600oC、可旋转、可升降；配辅助磁控溅射阴极；配备HiPIMS电源和HiPIMS同步偏压电源，HiPIMS电源脉宽3.5-1000 μ s可调；配备等离子体质谱系统，实现离子能量分布函数和离子时间分布函数测定。 四、共用部分 沉积室间由高真空手动闸板连接，能够实现样品手动传递；配备冷水机。